



มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์

การสอบกลางภาค ประจำภาคการศึกษาที่ 1

ประจำปีการศึกษา 2554

วันที่ 1 สิงหาคม 2554

เวลา 9.00-11.00

วิชา 210-391 Microprocessor

ห้อง S201 R201 A402 หัวหุนยนต์

ทุจริตในการสอบโถยขึ้นค่ากือ ปรับตกในรายวิชาที่ทุจริตและพักการเรียน 1 ภาคการศึกษา

คำสั่ง

- ข้อสอบมี 4 ข้อ ให้ทำทุกข้อ
- ให้ตอบในกระดาษคำตอบ โดยใช้ ปากกาเจียนตอบในพื้นที่ที่จัดไว้ให้เท่านั้น ผู้ฝ่าฝืนจะไม่ได้รับการตรวจให้คะแนน
- ไม่อนุญาตให้นำตำราและเครื่องคิดเลขเข้าห้องสอบ

1.1 “The 4-bit 4004 ran at 108 kHz, contained 2300 transistors. The speed of this 1971 device was estimated at 0.06 MIPS. By comparison, in 2000 Intel's Pentium ran at 133 MHz, contained 5.5 million transistors. Intel's Pentium could execute 300 MIPS.”

MIPS คืออะไร สามพันธ์กับความเร็วในการทำงานอย่างไร

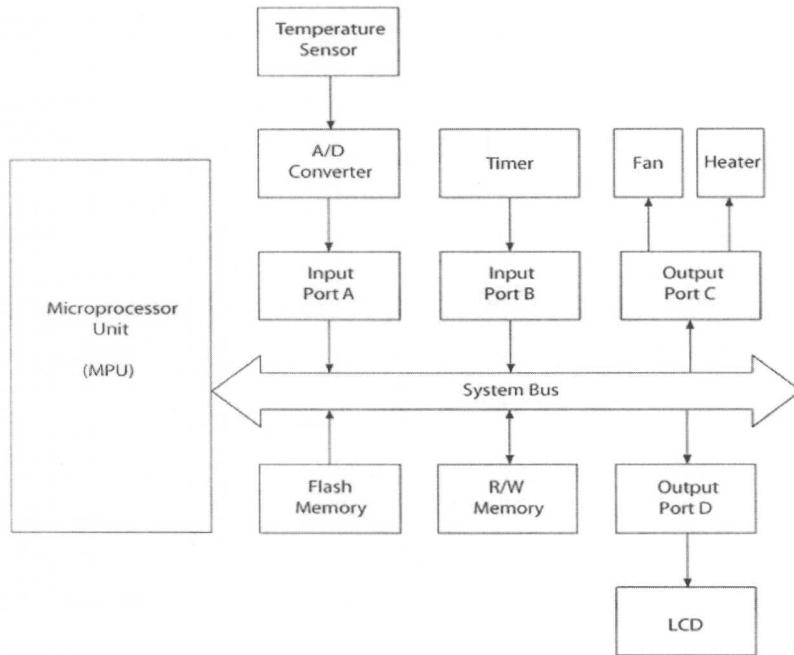
(2)

1.2 จากตารางแสดงการเปรียบเทียบผลของการลดขนาด minimum dimension จาก 0.8 ไมครอนเป็น 0.6 ไมครอน ให้อธิบายผลของ throughput และ power consumption พร้อมเหตุผล (4)

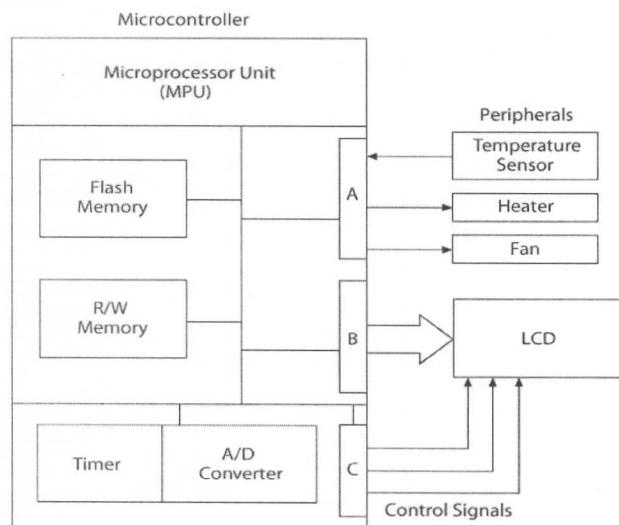
Scaling the Intel Pentium processor

Minimum dimension	(μm)	0.8	0.6
Area of chip	(mm^2)	284	163
Maximum clock speed	(MHz)	66	100
Supply voltage	(V)	5	3.3

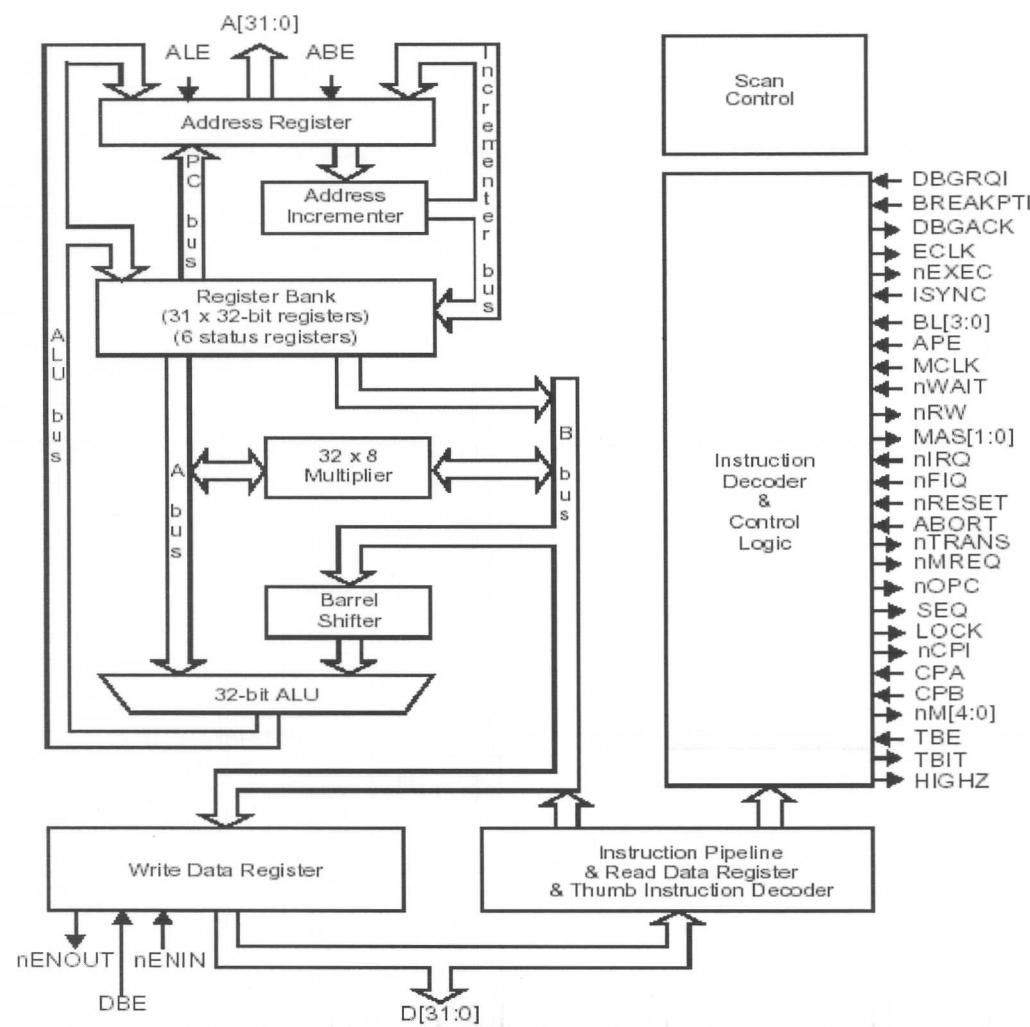
- 1.3 Moore's Law គឺខ្លះនៅ តារាងតាមគឺខ្លះនៅ (2)
- 1.4 របៀប Time and Temperature System សរ៍បានដើម្បីរួម (ក) ឬ (ខ) កើតឡើងប្រើប្រាស់ពីរបៀបទីនៃការសរ៍បាន
ដើម្បីពិចារណាទឹង ឱ្យការ និង ការសាមរាតិនការខ្សាយរបៀប (2)



រូបរាង (ក)



រូបរាង (ខ)



2. จาก block diagram จงบอกหน้าที่ของ

- 2.1 Write Data Register (1)
- 2.2 Address Register (1)
- 2.3 32x8 Multiplier (1)
- 2.4 Address Incrementer (1)
- 2.5 Register Bank (1)
- 2.6 Instruction Pipeline (1)
- 2.7 Read Data Register (1)
- 2.8 Instruction Decoder & Control Logic (1)
- 2.9 32-bit ALU (1)
- 2.10 Barrel Shifter (1)

3.1 จากภาษาระดับสูงต่อไปนี้ (2)

```
switch (R0) {
    case 0: S0(); break;
    case 1: S1(); break;
    case 2: S2(); break;
    case 3: S3(); break;
    default: err();
}
```

เมื่อแปลงเป็นภาษา assembly แล้ว ให้เติมคำสั่งที่เว้นว่างไว้ 2 คำสั่ง (คำสั่งหมายเลข 1 และ 2)

```
CMP R0, #0
BEQ S0
CMP R0, #1
BEQ S1
..... @ คำสั่งหมายเลข 1
BEQ S2
CMP R0, #3
BEQ S3
err: ...
..... @ คำสั่งหมายเลข 2
S0: ...
B Exit
S1: ...
B Exit
S2: ...
B Exit
S3: ...
Exit:
```

3.2 จากภาษา assembly ต่อไปนี้ให้เขียนภาษา C ต้นฉบับ (source code) (3)

```
CMP R0, R1
BLE XXX
MOV R2, R0
B YYY
XXX: MOV R2, R1
YYY:
```

3.3 จงเขียนภาษา assembly ของ ARM จากภาษา C ต่อไปนี้ (1)

While (1)

;

3.4 จงบอกเหตุผลที่บริษัท ARM กำหนดรูปแบบของการเข้าใช้และออกแบบจากโปรแกรมย่อย (2)

3.5 จงบอกหลักการทำ optimization ของ compiler มาเพียง 2 ข้อ (2)

4. จาก datasheet ของ LPC2138 ที่แนบ ถ้าต้องการออกแบบอุปกรณ์เก็บข้อมูลขณะออกแบบกล่องภายในที่ใช้ LPC2138 ให้ทำงานที่ความถี่ 28 MHz โดยให้อุปกรณ์เก็บข้อมูลใช้พลังงานงานจากแบตเตอรี่ 6 VDC

4.1 จงระบุคุณลักษณะเฉพาะของ crystal ที่ใช้กับวงจร LPC2138 พร้อมอธิบายเหตุผล (2)

4.2 ในสภาวะทำงาน ตัว LPC2138 กินกระแสอย่างต่ำกี่มิลลิแอมป์ ให้แสดงวิธีคำนวณด้วย (4)

4.3 จงระบุคุณลักษณะของ voltage regulator พร้อมอธิบายเหตุผล (2)

4.4 ถ้าระบบโดยส่วนใหญ่ทำงานอยู่ใน standby mode จงบอกแนวทางในการยืดอายุการใช้งานแบตเตอรี่ พร้อมอธิบายเหตุผล (2)

เกริกชัย ทองหนู ผู้ออกแบบ

8. Static characteristics

Table 6. Static characteristics

 $T_{amb} = -40^{\circ}\text{C}$ to $+85^{\circ}\text{C}$ for commercial applications, unless otherwise specified.

Symbol	Parameter	Conditions	Min	Typ ^[1]	Max	Unit	
V_{DD}	supply voltage (core and external rail)		3.0	3.3	3.6	V	
V_{DDA}	analog 3.3 V pad supply voltage		2.5	3.3	3.6	V	
$V_i(VBAT)$	input voltage on pin VBAT		[2]	2.0	3.3	V	
$V_i(VREF)$	input voltage on pin VREF		2.5	3.3	3.6	V	
Standard port pins, RESET, RTCK							
I_{IL}	LOW-level input current	$V_I = 0\text{ V}$; no pull-up	-	-	3	μA	
I_{IH}	HIGH-level input current	$V_I = V_{DD}$; no-pull-down	-	-	3	μA	
I_{OZ}	OFF-state output current	$V_O = 0\text{ V}$; $V_O = V_{DD}$; no pull-up/down	-	-	3	μA	
I_{latch}	I/O latch-up current	$-(0.5V_{DD}) < V_I < (1.5V_{DD})$; $T_j < 125^{\circ}\text{C}$	-	-	100	mA	
V_I	input voltage	pin configured to provide a digital function	[3][4][5] [6]	0	-	5.5	V
V_O	output voltage	output active	0	-	V_{DD}	V	
V_{IH}	HIGH-level input voltage		2.0	-	-	V	
V_{IL}	LOW-level input voltage		-	-	0.8	V	
V_{hys}	hysteresis voltage		0.4	-	-	V	
V_{OH}	HIGH-level output voltage	$I_{OH} = -4\text{ mA}$	[7]	$V_{DD} - 0.4$	-	V	
V_{OL}	LOW-level output voltage	$I_{OL} = -4\text{ mA}$	[7]	-	-	0.4	V
I_{OH}	HIGH-level output current	$V_{OH} = V_{DD} - 0.4\text{ V}$	[7]	-4	-	-	mA
I_{OL}	LOW-level output current	$V_{OL} = 0.4\text{ V}$	[7]	4	-	-	mA
I_{OHS}	HIGH-level short-circuit output current	$V_{OH} = 0\text{ V}$	[8]	-	-	-45	mA
I_{OLS}	LOW-level short-circuit output current	$V_{OL} = V_{DDA}$	[8]	-	-	50	mA
I_{pd}	pull-down current	$V_I = 5\text{ V}$	[9]	10	50	150	μA
I_{pu}	pull-up current	$V_I = 0\text{ V}$	[10]	-15	-50	-85	μA
		$V_{DD} < V_I < 5\text{ V}$	[9]	0	0	0	μA
$I_{DD(act)}$	active mode supply current	$V_{DD} = 3.3\text{ V}$; $T_{amb} = 25^{\circ}\text{C}$; code while(1) {} executed from flash, no active peripherals					
		$CCLK = 10\text{ MHz}$	-	10	-	mA	
		$CCLK = 60\text{ MHz}$	-	40	-	mA	
$I_{DD(pd)}$	Power-down mode supply current	$V_{DD} = 3.3\text{ V}$; $T_{amb} = 25^{\circ}\text{C}$ $V_{DD} = 3.3\text{ V}$; $T_{amb} = 85^{\circ}\text{C}$	-	60	-	μA	
			-	200	500	μA	

- [4] V_{DD} supply voltages must be present.
- [5] 3-state outputs go into 3-state mode when V_{DD} is grounded.
- [6] Please also see the errata note mentioned in the errata sheet.
- [7] Accounts for 100 mV voltage drop in all supply lines.
- [8] Only allowed for a short time period.
- [9] Minimum condition for $V_I = 4.5$ V, maximum condition for $V_I = 5.5$ V.
- [10] Applies to P1.16 to P1.25.
- [11] On pin VBAT.
- [12] Optimized for low battery consumption.
- [13] To V_{SS} .

9. Dynamic characteristics

Table 7. Dynamic characteristics

$T_{amb} = -40^{\circ}\text{C}$ to $+85^{\circ}\text{C}$ for commercial applications, V_{DD} over specified ranges.^[1]

Symbol	Parameter	Conditions	Min	Typ ^[2]	Max	Unit
External clock						
f_{osc}	oscillator frequency		10	-	25	MHz
$T_{cy(clk)}$	clock cycle time		40	-	100	ns
t_{CHCX}	clock HIGH time		$T_{cy(clk)} \times 0.4$	-	-	ns
t_{CLCX}	clock LOW time		$T_{cy(clk)} \times 0.4$	-	-	ns
t_{CLCH}	clock rise time		-	-	5	ns
t_{CHCL}	clock fall time		-	-	5	ns
Port pins (except P0.2 and P0.3)						
$t_{r(o)}$	output rise time		-	10	-	ns
$t_{f(o)}$	output fall time		-	10	-	ns
I²C-bus pins (P0.2 and P0.3)						
$t_{f(o)}$	output fall time	V_{IH} to V_{IL}	$20 + 0.1 \times C_b$ ^[3]	-	-	ns

[1] Parameters are valid over operating temperature range unless otherwise specified.

[2] Typical ratings are not guaranteed. The values listed are at room temperature (25°C), nominal supply voltages.

[3] Bus capacitance C_b in pF, from 10 pF to 400 pF.

ข้อ 1 (/10)

ข้อ 1.1 (/2)

.....
.....

ข้อ 1.2 (/4)

.....
.....

ข้อ 1.3 (/2)

.....
.....

ข้อ 1.4 (/2)

.....
.....

ข้อ 2 (/10)

ข้อ 2.1 Write Data Register (/1)

.....
.....

ข้อ 2.2 Address Register (/1)

.....
.....

ข้อ 2.3 32x8 Multiplier (/1)

.....
.....

ข้อ 2.4 Address Incrementer (/1)

.....
.....
.....

ข้อ 2.5 Register Bank (/1)

.....
.....
.....

ข้อ 2.6 Instruction Pipeline (/1)

.....
.....
.....

ข้อ 2.7 Read Data Register (/1)

.....
.....
.....

ข้อ 2.8 Instruction Decoder & Control Logic (/1)

.....
.....
.....

ข้อ 2.9 32-bit ALU (/1)

.....
.....
.....

ข้อ 2.10 Barrel Shifter (/1)

.....
.....
.....

วิชา 210-391 ชื่อ รหัส 3/4

ข้อ 3 (/10)

ข้อ 3.1 (/2)

- @ คำสั่งหมายเลข 1
..... @ คำสั่งหมายเลข 2

ข้อ 3.2 (/3)

.....
.....
.....
.....
.....
.....

ข้อ 3.3 (/1)

.....
.....
.....
.....
.....

ข้อ 3.4 (/2)

.....
.....
.....

ข้อ 3.5 (/2)

.....
.....
.....

ข้อ 4

ข้อ 4.1 (/2)

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

ข้อ 4.2 (/4)

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

ข้อ 4.3 (/2)

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

ข้อ 4.4 (/2)

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....